

材料の形態評価にはナノスケールのレベルで構造を観察できる HR-TEM（高分解能透過型電子顕微鏡）が不可欠です。

ここでは下記の図に示された CVD による SiC 成長過程においてドーパントガスをパルス上に導入する手法によって、デルタドープ層を形成させたサンプルを HR-TEM（日本電子：JEM-4000EX）により観察した例を紹介します。HR-TEM 像からデルタドープ層の厚さは 2nm と評価できました。

